Docket No. 246642US6

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Stephane GETIN, et al.			GAU:		
SERIAL N	O:NEW APPLICATION		EX	AMINER:	
FILED:	HEREWITH				
FOR: BIOSENSOR WITH AN ARBITRARY SUBSTRATE TO PHOTOTHERMAL DEFLECTION			HAT CAN BI	E CHARACTERISED IN	
		REQUEST FOR PRIC	PRITY		
	IONER FOR PATENTS DRIA, VIRGINIA 22313				
SIR:					
	nefit of the filing date of U.S. A ons of 35 U.S.C. §120.	Application Serial Number	, filed	, is claimed pursuant to the	
☐ Full benefit of the filing date(s) of V §119(e):		S. Provisional Application(s) pplication No.	is claimed pur <u>Date Fil</u>		
	ants claim any right to priority to visions of 35 U.S.C. §119, as n		tions to which	they may be entitled pursuant to	
In the matte	er of the above-identified applic	cation for patent, notice is he	reby given tha	t the applicants claim as priority:	
COUNTRY France		PPLICATION NUMBER 2 16325		DNTH/DAY/YEAR cember 20, 2002	
Certified co	opies of the corresponding Con-	vention Application(s)			
	submitted herewith				
	be submitted prior to payment				
□ wer	e filed in prior application Seri	al No. filed			
Rec	e submitted to the International eipt of the certified copies by the nowledged as evidenced by the	he International Bureau in a		under PCT Rule 17.1(a) has been	
□ (A)	Application Serial No.(s) were	filed in prior application Se	rial No.	filed ; and	
□ (B)	Application Serial No.(s)				
	are submitted herewith				
	will be submitted prior to pa	nyment of the Final Fee			
			Respectfully	Submitted,	
				VAK, McCLELLAND, EUSTADT, P.C.	
			Gregory J. M	mm MErllant	
Customer Number			Registration 1		
			C. Irvin McClelland		
22850 Tel. (703) 413-3000			Registration Number 21,124		

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 05/03)

THIS PAGE BLANK (USPTO)





BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 23 OCT. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpi.fr





BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

cerfa

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

BR1

75800 Paris Cedex 08 Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 540 0 7 / 210502 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE Réservé à l'INPI REMISE DEPECTS EC 2002 À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE 75 INPI PARIS FIFE **BREVATOME** 0216325 Nº D'ENREGISTREMENT 3, rue du Docteur Lancereaux NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 2 0 DEC. 2002 **75008 PARIS** DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 422-5 S/002 PAR L'INPI Vos références pour ce dossier DD 2438 (facultatif) B 14249.3 ID N° attribué par l'INPI à la télécopie Confirmation d'un dépôt par télécopie Cochez l'une des 4 cases suivantes 2 NATURE DE LA DEMANDE X Demande de brevet Demande de certificat d'utilité Demande divisionnaire Date Demande de brevet initiale Date Nº ou demande de vertificat d'utilité initiale Transformation d'une demande de brevet européen Demande de brevet initiale TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) BIOCAPTEUR A SUBSTRAT QUELCONQUE POUVANT ETRE CARACTERISE EN DEFLEXION **PHOTOTHERMIQUE** Pays ou organisation **A** DÉCLARATION DE PRIORITÉ Nº Date OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE Pays ou organisation No LA DATE DE DÉPÔT D'UNE Date ___ DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE Pays ou organisation S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» Personne physique Personne morale 5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases) [X] COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE Nom ou dénomination sociale Prėnoms Etablissement Public de Caractère Scientifique, Technique et Industriel Forme juridique Nº SIREN Code APE-NAF 31-33, rue de la Fédération Domicile OU 17 5 7 5 2 PARIS 15ème Code postal et ville siege FRANCE Pays. française Nationalite N° de télécopie (facultatif) N° de téléphone (facultatif) Adresse électronique (facultatif)



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ





BR2

ISE OPERPECES C 2002	and the control of th	•	
75 INPI PARIS			
021632(5		
PENREGISTREMENT IONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		DB 240 M \ S10205	
MANDATAIRE (s'il y a lieu)			
Nom	DJORDJALIAN		
Prénom	Valérie		
Cabinet ou Société	BREVATOME	a e e	
N °de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel	PG 7068	, general	
Rue	3, rue du Docteur Lancereaux		
Adresse Code postal et ville	[7 5 0 0 8]PARIS		
Pays	FRANCE	and the second s	
N° de téléphone (facultatif)	01 53 83 94 00	المناف ال	
N° de télécopie (facultatif)	01 45 63 83 33		
Adresse électronique (facultatif)	brevets.patents@brevalex.com	hravets natents@hrevalex.com	
7 INVENTEUR (S)	Les inventeurs sont nécessairement des pe	ersonnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes	Oui Non: Dans ce cas remplir le formulai	re de Désignation d'inventeur(s)	
RAPPORT DE RECHERCHE	Uniquement pour une demande de brevet	(y compris division de d'anticon	
Établissement immé	diat 🗶		
ou établissement dif	<u>Uniquement pour les personnes physiques ef</u>	fectuant elles-mêmes leur propre dépôt	
Paiement échelonné de la redevance (en deux rensements)	Oui Non		
P RÉDUCTION DU TAUX	Uniquement pour les personnes physique	S	
DES REDEVANCES	Requise pour la première fois pour cette in	cette invention (joindre une copie de la	
	décision d'admission à l'assistance gratuite ou in	<u> </u>	
SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS	Cochez la case si la description contient u	ne liste de séquences	
Le support électronique de données es	t joint		
La déclaration de conformité de la list séquences sur support papier avec support électronique de données est j	e de le	·	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Sui			
Si vous avez utilise l'imprime additi indiquez le nombre de pages joint	es	VISA DE LA PRÉFECTURE	
SIGNATURE DU DEMANDEUR		OU DE L'INPI	
OU DU MANDATAIRE			
(Nom et qualité du signataire)		C. TRAN	
V. DJORDJALIAN	17 del		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

1

BIOCAPTEUR A SUBSTRAT QUELCONQUE POUVANT ETRE CARACTERISE EN DEFLEXION PHOTOTHERMIQUE

DESCRIPTION

5 DOMAINE TECHNIQUE

10

30

La présente invention concerne un support d'échantillon utilisable dans un procédé de détection surfacique de composants absorbants placés sur ledit support d'échantillon à l'aide de méthodes de déflexion photothermique. L'invention a trait également à un dispositif de détection photothermique utilisant le support d'échantillon selon l'invention.

peut s'appliquer invention Cette la cartographie surface telle que l'analyse de 15 d'absorption ou l'imagerie de paramètre thermique, ainsi qu'au domaine général de la détection et de l'analyse d'une reconnaissance moléculaire entre une 🕫 première et une deuxième molécule, par exemple biologie moléculaire. La reconnaissance moléculaire 20 interaction spécifique peut être définie comme une plus ou moins complexes, molécules deux molécules liaison des deux une à conduisant suffisamment stable pour que les molécules puissent être détectées liées. Il peut s'agir par exemple d'une 25 hybridation d'acides nucléiques (ADN et/ou ARN), d'une réaction de reconnaissance de type antigène/anticorps, d'une interaction de type protéine/protéine, interaction de type enzyme/substrat, etc...

Le dispositif selon l'invention trouvera notamment une application dans la détection

d'hybridation d'oligonucléotides sur support solide, en milieu aqueux ou à l'air, par exemple dans le cadre d'un criblage (« screening » en anglais) ou d'une détection d'hybridation sur une biopuce.

5

20

30

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

Il existe plusieurs méthodes de détection surface. absorbantes sur une substances s'intéressera plus particulièrement aux méthodes 10 détection photothermique dont une présentation complète peut être trouvée dans l'ouvrage de Bialkowski [1], dont la référence est indiquée à la fin de cette description.

Parmi les méthodes de détection 15 photothermique se trouve la méthode de photothermique.

Soit une couche de substance absorbante déposée sur à étudier échantillon) (appelée substrat. Lorsque cet échantillon est irradié par un faisceau lumineux, dit faisceau « pompe », il absorbe une partie de l'énergie lumineuse incidente du faisceau (le reste de cette énergie lumineuse peut être rayonné ou donner naissance à de la fluorescence ou à une réaction chimique par exemple). Cette absorption va 25 provoquer un échauffement de l'échantillon, qui, par conduction thermique, va chauffer le substrat et le superstrat attenants. L'élévation de température due à l'absorption est en général inhomogène et donne donc lieu à un gradient d'indice du milieu analysé et des milieux adjacents, la densité des milieux étant rendue inhomogène par l'élévation de température. En faisant passer un faisceau de lumière, dit faisceau « sonde », dans la zone où l'échantillon a été irradié, dudit faisceau la une déviation due observer différence de gradients d'indice. En mesurant cette on va pouvoir quantifier le gradient déviation, en déduire ainsi la température et question, et l'absorption de l'échantillon.

L'avantage de la méthode photothermique est qu'elle n'est sensible qu'à l'absorption de la couche de substance et non à sa diffusion.

10

De plus, cette technique est beaucoup plus sensible que la méthode de spectrophotométrie. En effet, on peut obtenir une détection des pertes par absorption avec une précision de l'ordre du ppm, où le terme "pertes" désigne le rapport entre la puissance absorbée par l'échantillon et la puissance lumineuse incidente reçue.

ç

utilisée dans le domaine de la détection en biologie.

Elle peut en effet être utilisée pour détecter de manière directe l'hybridation de l'ADN qui présente une forte absorption dans l'ultraviolet (voir le document [2]) ou bien pour qualifier les étapes technologiques menant au dépôt d'oligonucléotides sur des biopuces à ADN dans le cadre de la technique de dépôt par synthèse in situ (voir le document [3] référencé à la fin de la description).

Néanmoirs, pour que cette méthode soit 30 utilisable, il faut limiter le bruit de fond causé par l'absorption du substrat. En effet, l'absorption de la



lumière par le substrat doit être très faible afin de ne pas « noyer » le signal des substances à analyser dans le bruit de fond induit par le substrat (voir le document [4] référencé à la fin de la description).

Or il s'avère que les substrats couramment employés dans le domaine des biocapteurs (lames de microscope réalisées en verre floté ou encore en silicium) sont trop absorbants et satisfont très difficilement aux conditions précitées.

Il est donc bien souvent nécessaire d'utiliser des substrats en silice fondue présentant une très faible absorption mais dont le coût, en fonction de la pureté du matériau, peut être important.

Pour des raisons de format, ces substrats sont par ailleurs mal adaptés aux dispositifs de réalisation (par exemple, les synthétiseurs commerciaux) et de caractérisation (scanners confocaux) employés par les biologistes.

De surcroît, les dispositifs actuels présentent l'inconvénient de devoir utiliser des sources lasers puissantes et bien souvent coûteuses afin d'assurer une détection correcte des substances.

EXPOSÉ DE L'INVENTION

10

15

Le dispositif selon l'invention vise à résoudre les inconvénients rencontrés dans l'art antérieur.

Ce but est atteint avec un support d'échantillon destiné à supporter un échantillon devant subir une détection et/ou une analyse par une méthode de détection photothermique mettant en œuvre un

.5

.10

faisceau pompe d'irradiation de l'échantillon et un et/ou de détection faisceau sonde caractérisé en ce qu'il comprend un substrat supportant un empilement de couches minces diélectriques formant miroir de Bragg qui est destiné à supporter couches l'échantillon, l'empilement de diélectriques permettant de réfléchir le faisceau pompe qui lui parvient.

d'échantillon support Grâce au l'invention, l'empilement de couches minces optiques ou miroir de « Bragg » réfléchit le signal du faisceau pompe de sorte que le signal n'atteint pas le substrat absorbant. Ainsi, on n'a plus à s'inquiéter ! de l'absorption du substrat et on peut utiliser n'importe quel substrat comme support d'échantillon. On peut 15 noter que les éléments à analyser seront placés en surface de l'ensemble substrat-multicouche, comme *le montre la figure 2.

Le dépôt de la multicouche ou miroir de Bragg est caractérisé par l'alternance de films minces diélectriques qui n'absorbent pas la lumière à longueur d'onde du faisceau pompe. Ces films présentent successivement des indices de réfraction élevé et bas.

Avantageusement, miroir de Bragg le comportera des couches minces diélectriques d'indice de 25 réfraction élevé formées d'un matériau choisi parmi le groupe constitué de TiO2, HfO2, SiO3N4, Ta2O5, Al2O3 et In_2O_3 .

le miroir Avantageusement, comportera des couches minces diélectriques d'indice de 30



réfraction bas formées d'un matériau choisi parmi le groupe constitué de SiO_2 , MgF_2 et LiF.

Les couches minces diélectriques que l'on dépose sur le substrat doivent également avoir une épaisseur précise pour former un miroir de Bragg. L'épaisseur est calculée selon la formule suivante :

$$e = \frac{\lambda'}{4n/\cos(\theta)}$$

où n est l'indice du matériau considéré, λ' la longueur d'onde fictive du faisceau pompe, θ l'angle que fait le 10 faisceau dans la couche considérée par rapport à la normale à l'empilement.

Εt

$$\lambda' = \lambda \times \frac{\cos \theta_H + \cos \theta_B}{2}$$

avec λ la longueur d'onde du faisceau pompe, θ_{H} l'angle que fait le faisceau pompe avec la normale dans la couche haut indice et θ_{B} l'angle que fait le faisceau pompe avec la normale dans la couche bas indice.

L'angle θ se calcule par les lois de Descartes en utilisant la formule :

$$\theta = a \sin \left(\frac{n_{\sup} \times \sin(\theta_{ref})}{N} \right)$$

où θ_{ref} est l'angle d'incidence du faisceau pompe dans le milieu où se trouve l'échantillon à analyser et n_{sup} l'indice de réfraction de ce milieu. N sera, selon le cas, l'indice de réfraction de la couche haut indice si l'on calcule l'angle que fait le faisceau pompe avec la normale dans la couche haut indice, et sera l'indice de

5

15

25

réfraction de la couche bas indice si l'on calcule l'angle que fait le faisceau pompe avec la normale dans la couche bas indice.

Le dépôt des couches minces diélectriques peut être réalisé par dépôt physique en phase vapeur ou dépôt PVD (« Physical Vapor Deposition »), par dépôt chimique en phase vapeur ou CVD (« Chemical Vapor Deposition) ou par voie sol gel.

Avantageusement, la couche supérieure 10 formant le miroir de Bragg est biocompatible avec l'échantillon que l'on veut fixer sur le support d'échantillon.

Le support d'échantillon ainsi réalisé présente la propriété de réduire ou d'annuler la propagation du faisceau pompe vers le substrat, et ainsi le bruit de fond introduit par l'absorption du substrat dans les supports de l'art antérieur est limité ou supprimé.

100

Selon un mode particulier de l'invention, la couche supérieure formant le miroir de Bragg est une couche ayant un indice de réfraction bas.

Ainsi réalisé, le dispositif renforce l'intensité lumineuse au voisinage des substances à détecter en surface par rapport au substrat nu. Ceci présente deux avantages :

- on augmente la sensibilité de détection du support d'échantillon selon l'invention par rapport à un substrat seul,
- on peut diminuer l'intensité requise pour le laser pompe.

1 Ó



L'invention concerne également un dispositif de détection et/ou d'analyse d'un échantillon par une méthode photothermique, ledit dispositif comprenant un support d'échantillon selon l'invention, un moyen d'éclairage de l'échantillon supporté par ledit support et fournissant un faisceau pompe, un moyen de détection et/ou de mesure l'absorption ou de la réflexion du faisceau pompe par l'échantillon lorsqu'il est éclairé par ledit moyen d'éclairage.

Selon un mode particulier de l'invention, le dispositif comprendra en outre un moyen positionnement dudit moyen de détection et/ou de mesure. En effet, l'information obtenue ce 15 dispositif étant locale, le moyen de détection et/ou de mesure de l'absorption ou de la réflexion du faisceau pompe peut être couplé à un système de déplacement du support d'échantillon relativement au faisceau pompe. L'ensemble permet alors de comparer les valeurs de déviation du faisceau sonde d'un point à l'autre du support d'échantillon, en particulier le signal peut représenté sous forme de cartographie. Selon être l'invention, le moyen de positionnement du support peut être tout moyen connu de déplacement précis dudit 25 support d'échantillon par exemple des platines de translation et de rotation micrométrique:

Avantageusement, le moyen d'éclairage de 'l'échantillon fournissant le faisceau pompe sera une source laser.

Avantageusement, le moyen de détection et/ou de mesure de l'absorption ou de la réflexion par

10

30

lumière de source l'échantillon comprendra une procurant un faisceau sonde et des moyens de détection ou de mesure de la déviation du faisceau sonde.

Avantageusement, le faisceau sonde aura une absorbée par n'est pas d'onde qui lonqueur l'échantillon. De même, la source de lumière sera avantageusement une source laser.

Selon un mode particulier de l'invention, les moyens de détection de la déviation du faisceau sonde comportent une photodiode multi-élément ou une photodiode simple. La photodiode multi-élément pourra être choisie parmi le groupe constitué d'un détecteur à deux ou quatre quadrants, d'un détecteur barrette, d'un détecteur matriciel, tandis que la photodiode simple 15 sera soit partiellement recouverte par un cache gou couteau, soit ne recevra qu'une partie du faisceau sonde.

de détection composants des Le mode absorbants pourra être direct : la substance à détecter 20 absorbe la lumière envoyée sur l'échantillon si la dispositif de fonctionnement du d'onde lonqueur correspond à la longueur d'onde d'absorption de la substance. En d'autres termes, il y aura absorption si la longueur d'onde du faisceau pompe est choisie de manière à ce que l'échantillon soit absorbant à cette 25 longueur d'onde.

Le mode de détection peut également être indirect. Dans ce cas, les substances à détecter sont équipées de marqueurs qui absorbent la lumière envoyée sur l'échantillon à la longueur d'onde du faisceau pompe. En d'autres termes, la longueur d'onde



faisceau pompe est choisie de manière à ce que des marqueurs équipant l'échantillon soient absorbants à cette longueur d'onde. Les marqueurs absorbants pourront être, par exemple, un colorant, des particules métalliques ou des boîtes quantiques (« quantum-dots » en anglais).

Enfin, l'invention concerne l'utilisation de ce dispositif pour un test, un diagnostic ou une 10 détection d'hybridation d'oligonucléotides, en milieu liquide ou dans l'air, sur support solide dans le cadre du « screening » ou de la détection d'hybridation sur des biopuces.

15 BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

20

L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages et particularités apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre, donnée à titre d'exemple non limitatif, accompagnée des dessins annexés parmi lesquels :

- la figure 1 est un schéma illustrant une configuration possible pour un dispositif de mesure d'absorption par déflexion photothermique,
- la figure 2 est un schéma illustrant le dispositif de déflexion photothermique avec un substrat comportant une multicouche selon l'invention.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE MODES DE RÉALISATION DE L'INVENTION

5

10

15

L'orientation du faisceau pompe par rapport au faisceau sonde peut être choisie à loisir, par exemple en fonction de l'encombrement mécanique et/ou pour optimiser la sensibilité en cherchant le maximum d'absorption en fonction de l'angle d'incidence. Mais concernant le faisceau sonde, il faut qu'il soit placé de manière à ce qu'il traverse la zone dans laquelle l'échantillon à analyser a été irradié par le faisceau pompe. En effet, c'est cette traversée du faisceau sonde par des gradients d'indices différents qui : va provoquer la déviation dudit faisceau sonde et ainsi permettre de mesurer l'absorption de l'échantillon. Dans la figure 2, on a placé le faisceau sonde 22 de support manière à ce qu'il rase la surface du d'échantillon 10.

Sur la figure 1, les faisceaux sonde et pompe se croisent en formant un angle choisi. La référence 1 indique le faisceau pompe, la référence 2 20 la référence 3 le sonde, faisceau d'échantillon, sur lequel on a positionné l'échantillon de mesure, la référence 4 représente un détecteur ; la référence 5 est une tache lumineuse formée par le faisceau sonde sur le détecteur 4 lorsqu'on utilise un 25 échantillon de référence non absorbant, et la référence 6 est une tache lumineuse formée par le faisceau sonde sur le détecteur 4 lorsqu'on utilise l'échantillon à analyser. On voit bien qu'entre les deux taches 5 et 6, il y a eu une déviation du faisceau sonde, ce qui 30

10

15



indique qu'il y a eu absorption d'une certaine quantité du faisceau pompe par l'échantillon à analyser.

Sur la figure 2, on a une représentation détaillée du dispositif de déflexion photothermique utilisant le support d'échantillon selon l'invention. Le support d'échantillon 10 est composé d'un substrat 11 sur lequel on a déposé une multicouche 12; l'échantillon 13 à analyser est placé sur la multicouche 12. On envoie un faisceau pompe incident 21a sur l'échantillon 13 (une partie du faisceau pompe est réfléchi, voir la référence 21b) et on mesure l'absorption de l'échantillon en mesurant la déviation d'un faisceau sonde 22.

Le substrat utilisé selon l'invention pourra être quelconque dans la mesure où il sera apte à recevoir des dépôts de couches minces désirées. Le substrat pourra être par exemple du silicium ou du verre.

Par exemple, pour un faisceau pompe de longueur d'onde λ = 514 nm, le support d'échantillon comportera un substrat de verre et une multicouche constituée de l'alternance de couches minces diélectriques 12a en silice et d'épaisseur 100 nm, et de couches minces diélectriques 12b en dioxyde d'hafnium et d'épaisseur 75 nm. Cette multicouche sera composée de 20 couches minces.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] S.E. BIALKOWSKI, Photothermal Spectroscopy

 Methods for Chemical Analysis, Wiley-Interscience

 Publication 1996, ISBN 0-471-57467-8.
- [2] P. CHATON, L. POUPINET, F. GINOT, A. NOVELLI ROUSSEAU, Procédé et dispositif de détection d'une réaction de reconnaissance moléculaire, demande de brevet FR-A-2 799 281.
- [3] P. CHATON, F. VINET, Procédé et dispositif d'analyse d'acides nucléiques fixés sur d'un support, demande de brevet FR-A-2 799 282.
- [4] ADELHELM et al, Development of a sensitive detection system based on the photothermal effect for biomolecular interaction studies, SPIE proceedings, vol. 2629, pages 325-333.

REVENDICATIONS

1. Support d'échantillon (3, 10) destiné à supporter un échantillon (13) devant subir une détection et/ou une analyse par une méthode de détection photothermique mettant en œuvre un faisceau pompe (21a) d'irradiation de l'échantillon (13) et un faisceau sonde (22) de détection et/ou d'analyse, caractérisé en ce qu'il comprend un substrat (11) supportant un empilement de couches minces diélectriques formant un miroir de Bragg (12) qui est destiné à supporter l'échantillon (13), l'empilement de couches minces diélectriques permettant de réfléchir le faisceau pompe (21a) qui lui parvient.

15

- 2. Support d'échantillon (3, 10) selon la revendication 1, caractérisé en ce que le miroir de Bragg (12) comporte des couches minces diélectriques d'indice de réfraction élevé formées d'un matériau choisi parmi le groupe constitué de TiO₂, HfO₂, SiO₃N₄, Ta₂O₅, Al₂O₃ et In₂O₃.
- 3. Support d'échantillon (3, 10) selon la revendication 1, caractérisé en ce que le miroir de 25 Bragg (12) comporte des couches minces diélectriques d'indice de réfraction bas formées d'un matériau choisi parmi le groupe constitué de SiO₂, MgF₂ et LiF.
- 4. Support d'échantillon (3, 10) selon la 30 revendication 1, caractérisé en ce que la couche

supérieure formant le miroir de Bragg (12) est biocompatible avec l'échantillon (13).

- 5. Support d'échantillon (3, 10) selon la revendication 1, caractérisé en ce que la couche supérieure formant le miroir de Bragg (12) est une couche ayant un indice de réfraction bas.
- 6. Dispositif de détection et/ou d'analyse d'un échantillon (13) par une méthode photothermique, ledit dispositif comprenant un support d'échantillon (3, 10) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, un moyen d'éclairage de l'échantillon supporté par ledit support et fournissant un faisceau pompe (1, 21a), un moyen de détection et/ou de mesure de l'absorption ou de la réflexion du faisceau pompe par l'échantillon lorsqu'il est éclairé par ledit moyen d'éclairage.

7

- 7. Dispositif selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un moyen de positionnement dudit moyen de détection et/ou de mesure.
- 8. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que le moyen d'éclairage de l'échantillon fournissant le faisceau pompe (1, 21a) est une source laser.
- 30 9. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que le moyen de détection et/ou de



mesure de l'absorption ou de la réflexion du faisceau pompe par l'échantillon comprend une source de lumière procurant un faisceau sonde (2, 22) et des moyens de détection de la déviation de ce faisceau sonde.

5

15

- 10. Dispositif selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les moyens de détection de la déviation du faisceau sonde (2, 22) comportent une photodiode multi-élément ou une photodiode simple.
 - 11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 6 à 10, caractérisé en ce que la longueur d'onde du faisceau pompe (1, 21a) est choisie pour que l'échantillon (13) soit absorbant à cette longueur d'onde.
- 12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 6 à 10, caractérisé en ce que la longueur d'onde du faisceau pompe (1, 21a) est choisie pour que des marqueurs équipant l'échantillon (13) soient absorbant à cette longueur d'onde.
- 13. Utilisation du dispositif selon l'une quelconque des revendications 6 à 12 pour un test, un diagnostic ou une détection d'hybridation d'oligonucléotides, en milieu liquide ou dans l'air, sur support solide dans le cadre du « screening » ou de la détection d'hybridation sur des biopuces.

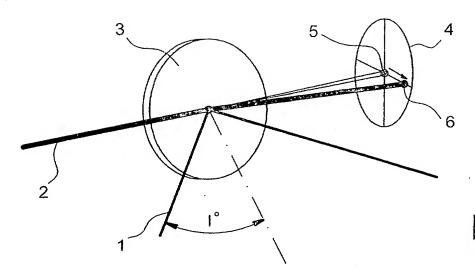


FIG. 1

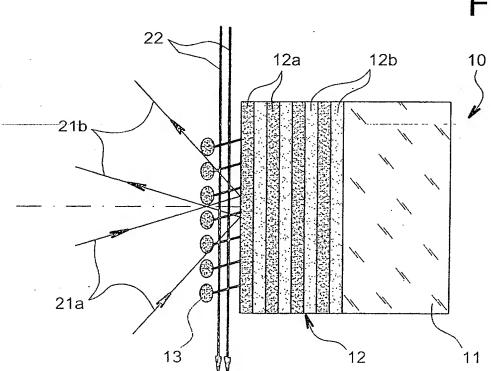


FIG. 2



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

éphone : 33 (1) 53 04	53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire 09 113 9 W / 270601
loo wátázancas n	our ce dossier (facultatif)	B 14249.3 ID A 169 96
los références pour ce dossier (facultatif) N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		Q163 W
4º D'ENREGISTR	NTION (200 caractères ou esp	naces maximum)
	R A SUBSTRAT QUE	ELCONQUE POUVANT ETRE CARACTERISE EN DEFLEXION
LE(S) DEMANDE	:IIB(S) ·	
	ARIAT A L'ENERGIE	ATOMOUE
31-33, rue d 75752 PARI FRANCE	e la Fédération	- -
Nom		GETIN
Prénoms		Stéphane
Adresse	Rue	41, rue des Eaux Claires
7107000	Code postal et ville	[3 8 1 0 0] GRENOBLE FRANCE
Société d'ap	partenance (facultatif)	
		GAUGIRAN
Nom Prénoms		Stéphanie
Adresse	Rue	6, rue Vicat
7 lat 0 d b	Code postal et ville	[3 8 0 0 0] GRENOBLE FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)		
Nom Nom		N. P. C. P.
Prénoms		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Carling the second of the self		大学 大
S'il y a nhu	s de trois inventeurs, utilisez	plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages
DATE ET S DU (DES) OU DU MA	SIGNATURE(S) DEMANDEUR(S) ANDATAIRE qualité du signataire) décembre 2002	

V. DJORDJALIAN

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative at informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.